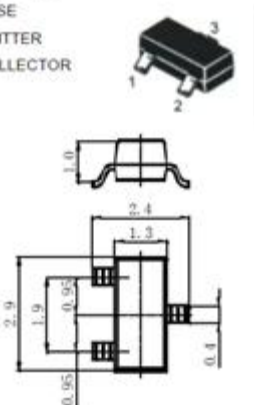


最大额定值 (Ta=25°C) SOT-23

参数	符号	规格	单位
集电极-基极电压	V_{CBO}	75	V
集电极电流	I_C	600	mA
集电极功耗	PC	625	mW
结温	T_j	150	°C

SOT-23

1. BASE
2. EMITTER
3. COLLECTOR



Unit : mm

电特性 (Ta=25°C)

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
集电极-基极击穿电压	BV_{CBO}	$I_C=100\mu A, I_E=0$	60			V
集电极-发射极击穿电压	BV_{CEO}	$I_C=1mA, I_B=0$	40			V
发射极-基极击穿电压	BV_{EBO}	$I_E=100\mu A, I_C=0$	6			V
集电极-发射极截止电流	I_{CEO}	$V_{CE}=35V, I_B=0$			20	nA
集电极-基极截止电流	I_{CBO}	$V_{CB}=55V, I_E=0$			10	nA
发射极-基极截止电流	I_{EBO}	$V_{EB}=4V, I_C=0$			10	nA
直流电流增益	hFE	$V_{CE}=10V, I_C=150mA$	100		300	
		$V_{CE}=10V, I_C=1mA$	60			
集电极-发射极饱和电压	$V_{CE(sat)}$	$I_C=500mA, I_B=50mA$			1.0	V
基极-发射极饱和电压	$V_{BE(sat)}$	$I_C=500mA, I_B=50mA$			2.0	V
特征频率	f_T	$V_{CE}=20V, I_C=20mA, f=100MHz$	250			MHz
延迟时间	t_d	$V_{CC}=30V, I_C=150mA, I_{B1}=15mA$			10	nS
上升时间	t_r				25	nS
储存时间	t_s	$V_{CC}=3V, I_C=150mA, I_{B1}=-I_{B2}=15mA$			225	nS
下降时间	t_f				60	nS

HFE 分档范围: (允许测试误差 10%)

L	H
100-200	200-300